

	<p>SI2301CDS-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI2301CDS-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 20V 3.1A SOT23-3</p> <p>Datenblätter:  SI2301CDS-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 506450 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI2301CDS-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET P-CH 20V 3.1A SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	506450 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3 (TO-236)
Verlustleistung (max)	860mW (Ta), 1.6W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3.1A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	112 mOhm @ 2.8A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	10nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	405pF @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±8V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI2301CDS-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI2301CDS-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI2301CDS-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI2301CDS-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI2301CDS-T1-CE3 VISHAY VISHAY SOT-23</p>	 <p>SI2301DS-E3 vishay SI2301DS-E3 vishay</p>	 <p>SI2301CDS-T1 VISHAY VISHAY SOT23</p>	 <p>SI2301DS-T1 VISAY SI2301DS-T1 VISAY</p>
 <p>SI2301CDS-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.1A SOT23-3</p>	 <p>SI2301DS-T1-E3 VISHAY SI2301DS-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI2301CDS-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 3.1A SOT23-3</p>	 <p>SI2301CDS Vishay SI2301CDS Vishay</p>

heiße Teile

Mehr

- | | | | | |
|--|--|--|---|--|
|  SI2196-A0A-GMR |  SI2300/AE9T |  SI2300BDS-T1-GE3 |  SI2300DS |  SI2300DS-T1 |
|  SI2300DS-T1-E3 |  SI2300DS-T1-GE3 |  SI2300DS-T1-GE3 |  SI2300DS-TI-E3 |  SI2301-TP |
|  SI2301A1SHB |  SI2301ADS |  SI2301ADS-T1-E3 |  SI2301ADS-T1-GE3 |  SI2301BDS |
|  SI2301BDS-E3 |  SI2301BDS-T1 |  SI2301BDS-T1-E3 |  SI2301BDS-T1-E3 |  SI2301BDS-T1-GE3 |
|  SI2301BDS-T1-GE3 |  SI2301CDS |  SI2301CDS-T1-E3 |  SI2301CDS-T1-E3 |  SI2301CDS-T1-GE3 |
|  SI2301DS |  SI2301DS-E3 |  SI2301DS-T1 |  SI2301DS-T1-E3 |  SI2301DS-T1-E3 |
|  SI2302ADS |  SI2302ADS-T1 |  SI2302ADS-T1 |  SI2302ADS-T1-E3 |  SI2302ADS-T1-E3 |
|  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302ADS-T1-GE3 |  SI2302BDS-T1-E3 |  SI2302CDS-T1-E3 |  SI2302CDS-T1-E3 |
|  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302CDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |  SI2302DDS-T1-GE3 |  SI2302DS |
|  SI2302DS-E3 |  SI2302DS-T1 |  SI2302DS-T1-E3 |  SI2302DS-T1-GE3 |  SI2302DV |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited